



Competitor Identifier

Who are they? From the whom?

Competitor Profile

What is about your competitors?

Journal Article Analysis

Research trend analysis based on journal articles

Knowledge Information Analysis System

COMPAS

Patent Citation Tree

What is the relationship between patents?

Tech Tree

Distribution of technologies in the field of interest

Tech Path

How far can you reach?

Core Patents

Competitor Patent Acquisition

What gaps to your competitor exist?

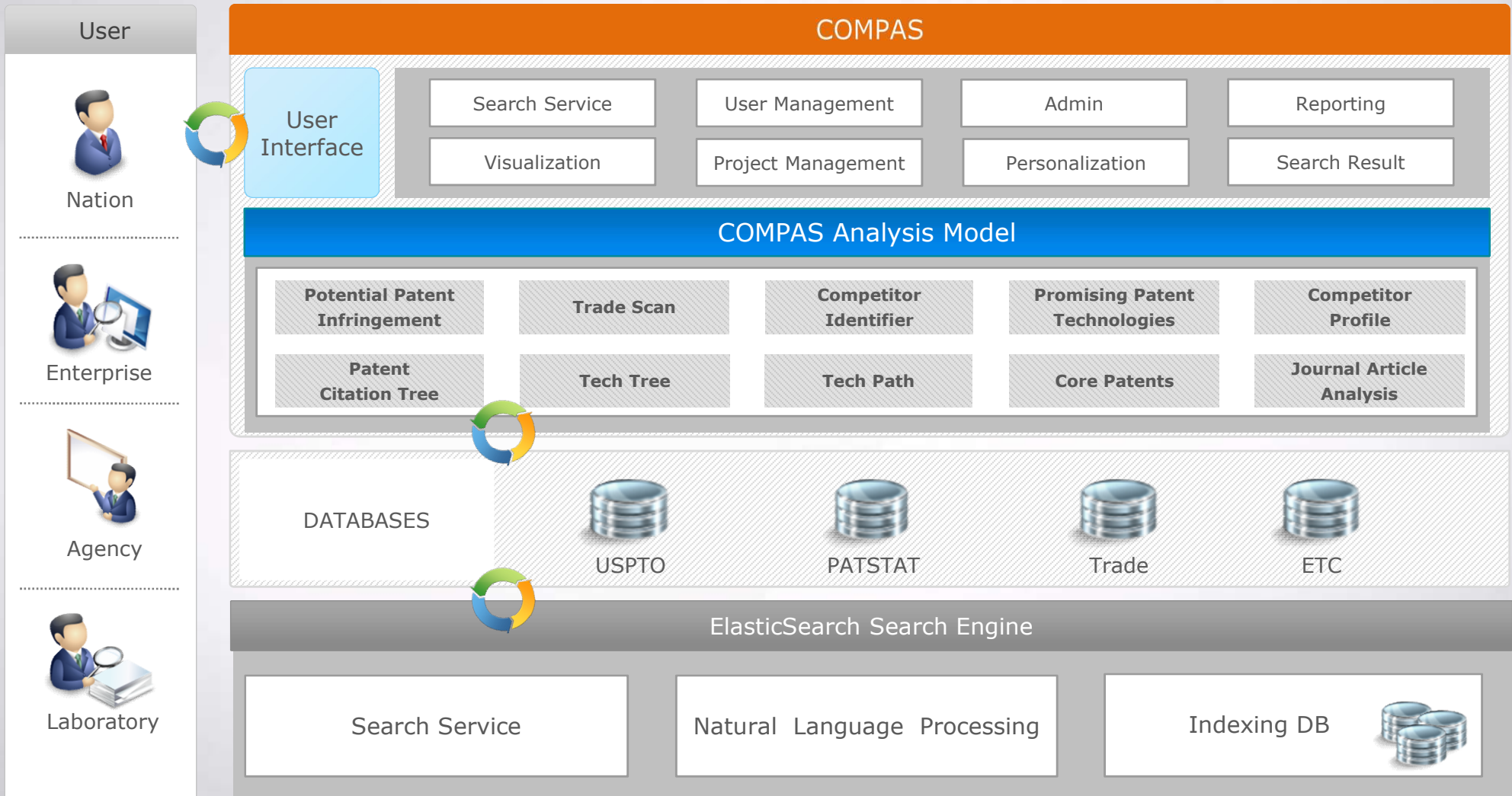
Question & Answer

COMPAS Manual



1. SYSTEM CONFIGURATION

Competitive Information Analysis, Technical Analysis, Database, Service Build a **One-Stop System.**



1. SYSTEM CONFIGURATION

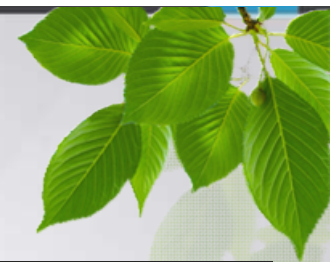
 An open search engine **keeps your system safe.**



Type	 ElasticSearch Engine	 Other Search Engine
Realtime Search	Possible 	Possible 
Data Format	JSON Format	Different for Searchengines
Dynamic Filed	Possible 	Different for Searchengines
Open Resource	Easy to use related materials	Not used
Data Join	Possible 	Different for Searchengines
Clustering	Possible 	Possible 
Application Example	Internal / International (Wikipedia, GitHub, KT cloudware, Tango)	Internal

2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 We guarantee **proven technology** for COMPAS system.



Technology Transfer

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	ASSIGNEE	NATION / APPLICATION NUMBER
competitor's profile analyzing service system, and method thereof	KISTI	KR/ 10-2012-0092520
competitor's thesis analyzing service system, and method thereof	KISTI	KR/ 10-2012-0092518
Apparatus and method of creating comprehension network with star type for intellectual property right by detecting similarity of description	KISTI	KR/ 10-2007-0071793
System and method for providing extensible technology/path search service	KISTI	KR/ 10-2014-0180250



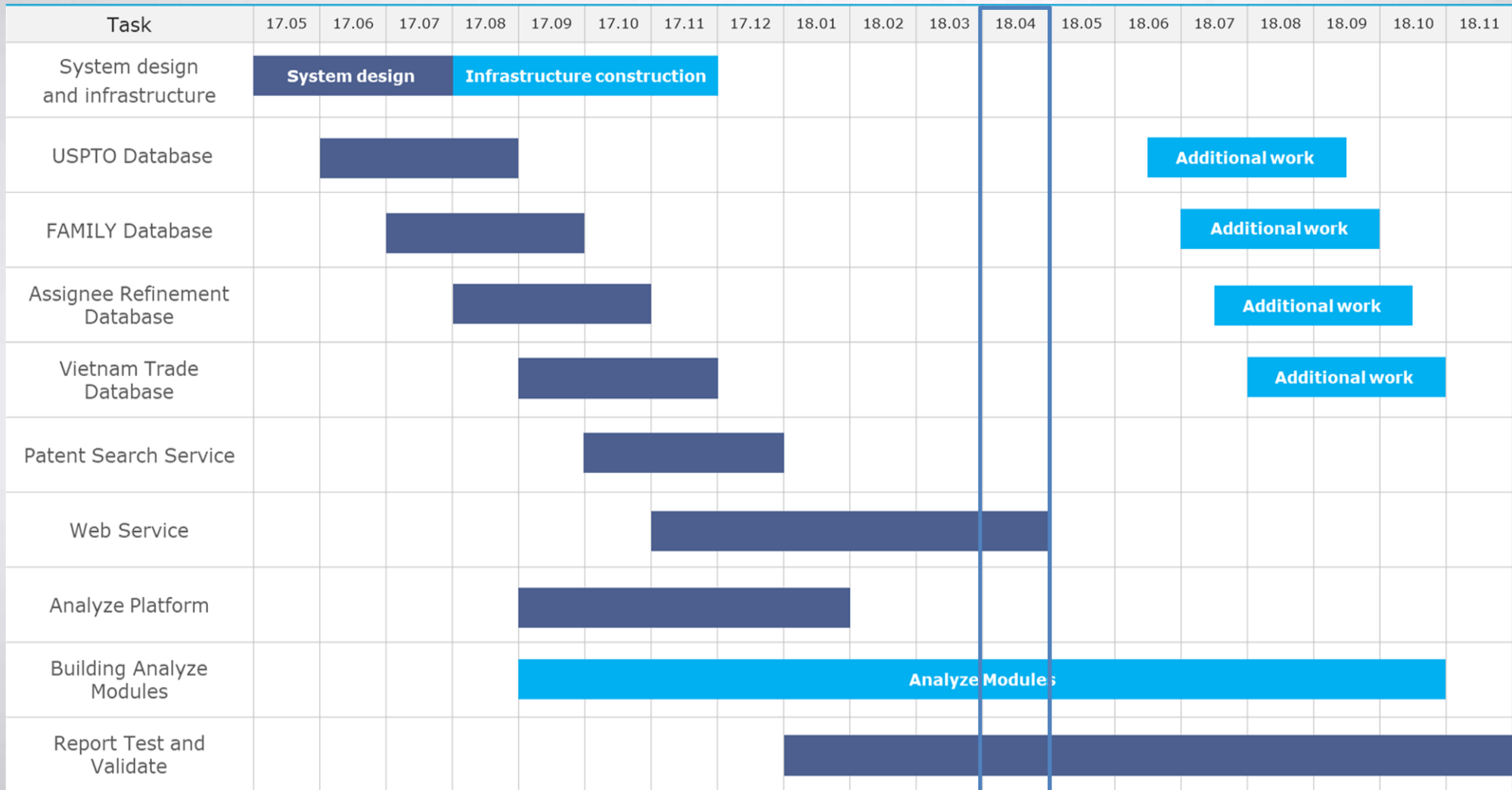
Program Registration

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	ASSIGNEE	NATION / APPLICATION NUMBER
Matrix Engine ver 1.0	MISOTECH	KR/C-2013-003320
Data Import Engine ver 1.0	MISOTECH	KR/C-2013-003321
Clustering Engine ver 1.0	MISOTECH	KR/C-2013-003322
FDP Engine ver 1.0	MISOTECH	KR/C-2013-003323
Strategy Diagram Engine ver 1.0	MISOTECH	KR/C-2013-003324

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	ASSIGNEE	NATION / APPLICATION NUMBER
Patent Citation Tree	KISTI	KR/C-2013-024179
Journal Article Analysis	KISTI	KR/C-2013-024178
Competitor Profile	KISTI	KR/C-2013-024177
Competitor Identifier	KISTI	KR/C-2013-024176
Trade Scan	KISTI	KR/C-2013-024175

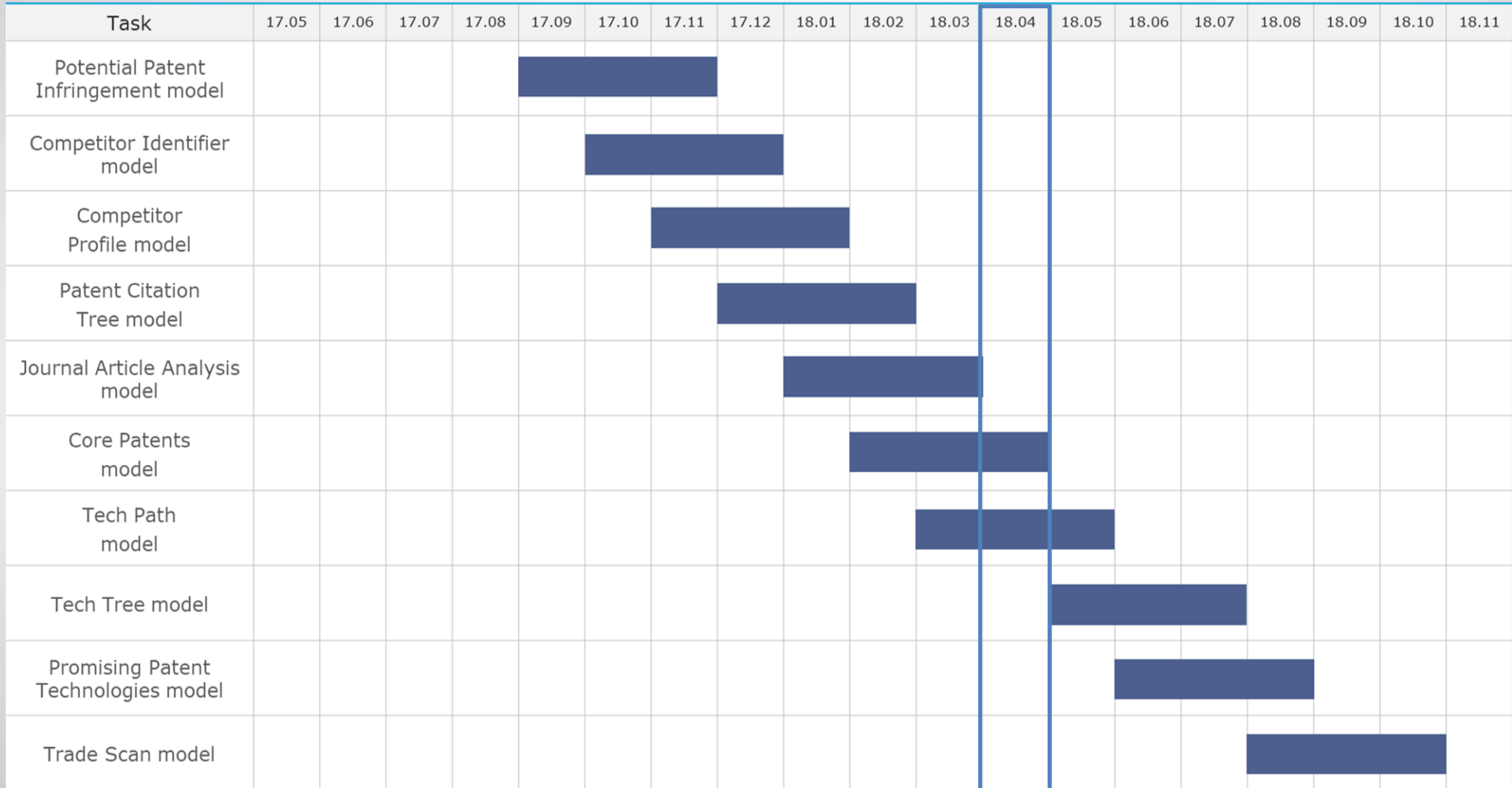
3. SCHEDULE GANTT CHART

☞ Ensure **optimized scheduling** and implementation, taking into account business characteristics and project duration.



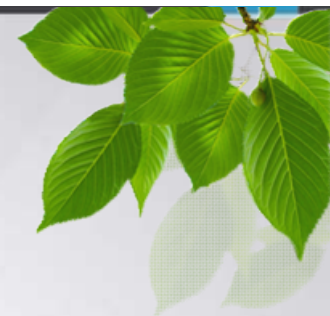
3. SCHEDULE GANTT CHART

☐ Ensure **optimized scheduling** and implementation, taking into account business characteristics and project duration.



4. TRANSLATE TO VIETNAMESE

 We provide **accurate information** through translation based on project characteristics.



Task	17.05	...	17.11	17.12	18.01	18.02	18.03	18.04	18.05	...	18.11
Potential Patent Infringement											
Trade Scan											
Competitor Identifier											
Competitor Profile											
Journal Article Analysis											
Patent Citation Tree											
Tech Tree											
Tech Path											
Core Patents											
Promising Patent Technologies											
My Page											
Administrator											

5. DEMO (Potential Patent Infringement)

Introduction

Khả năng vi phạm sáng chế

Giới thiệu

Bảng sáng chế quan tâm

Dự án

Mục đích của mô hình này là để phát hiện các bằng sáng chế tương tự như bằng sáng chế người sử dụng quan tâm.

Lĩnh vực công nghệ mà mô hình thực thi liên quan đến tập hợp các bằng sáng chế được chỉ định bởi người sử dụng. Sử dụng chức năng tìm kiếm bằng sáng chế COMPAS, người dùng có thể tìm kiếm lĩnh vực công nghệ mà họ quan tâm, và kết quả tìm kiếm được lưu trữ trong COMPAS. Trong quá trình thực hiện mô hình, người dùng chỉ định kết quả tìm kiếm như là một bộ bằng sáng chế sẽ được sử dụng để phân tích. Người sử dụng có thể chỉ định một bằng sáng chế cụ thể như là một "bằng sáng chế quan tâm (POI)" từ các kết quả tìm kiếm được chỉ định và phân tích sự tương tự giữa bằng sáng chế đó và các bằng sáng chế còn lại.

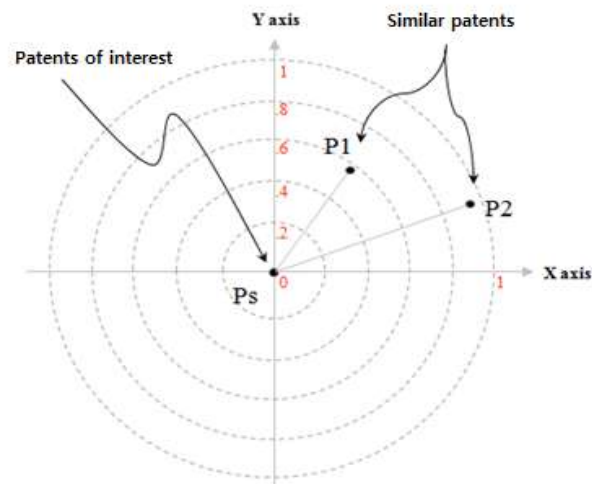
Các kết quả phân tích được trình bày trong hình ảnh dễ hiểu như sau. Trong hình này, POI nằm ở gốc tọa độ, và mức độ tương đương các bằng sáng chế khác so với POI được cho bằng "khoảng cách". Nói cách khác, các bằng sáng chế gần gốc tọa độ thì giống với POI hơn.

Sự tương tự giữa các bằng sáng chế được tính theo hai cách: bằng cách đo lường sự tương đồng của các thuật ngữ trích ra từ các yêu cầu bảo hộ của mỗi bằng sáng chế và sự tương tự trong phân loại bằng sáng chế. Sự tương đồng được biểu diễn bằng khoảng cách trên trục tọa độ Cartesian, với hai trục tương ứng với sự tương đồng về thuật ngữ và sự tương đồng về phân loại.

Mô hình này cung cấp các kết quả phân tích cùng với các kết quả tìm kiếm các bằng sáng chế tương tự. Các kết quả phân tích có thể tìm thấy trên trang web của COMPAS và có thể được lưu dưới dạng báo cáo riêng.

- Phân tích định lượng bằng sáng chế theo chuỗi thời gian
- Đo lường độ tương tự và danh sách bằng sáng chế tương tự
- Phân tích so sánh các bằng sáng chế có độ tương tự cao
- Xem xét chi tiết các bằng sáng chế tương tự

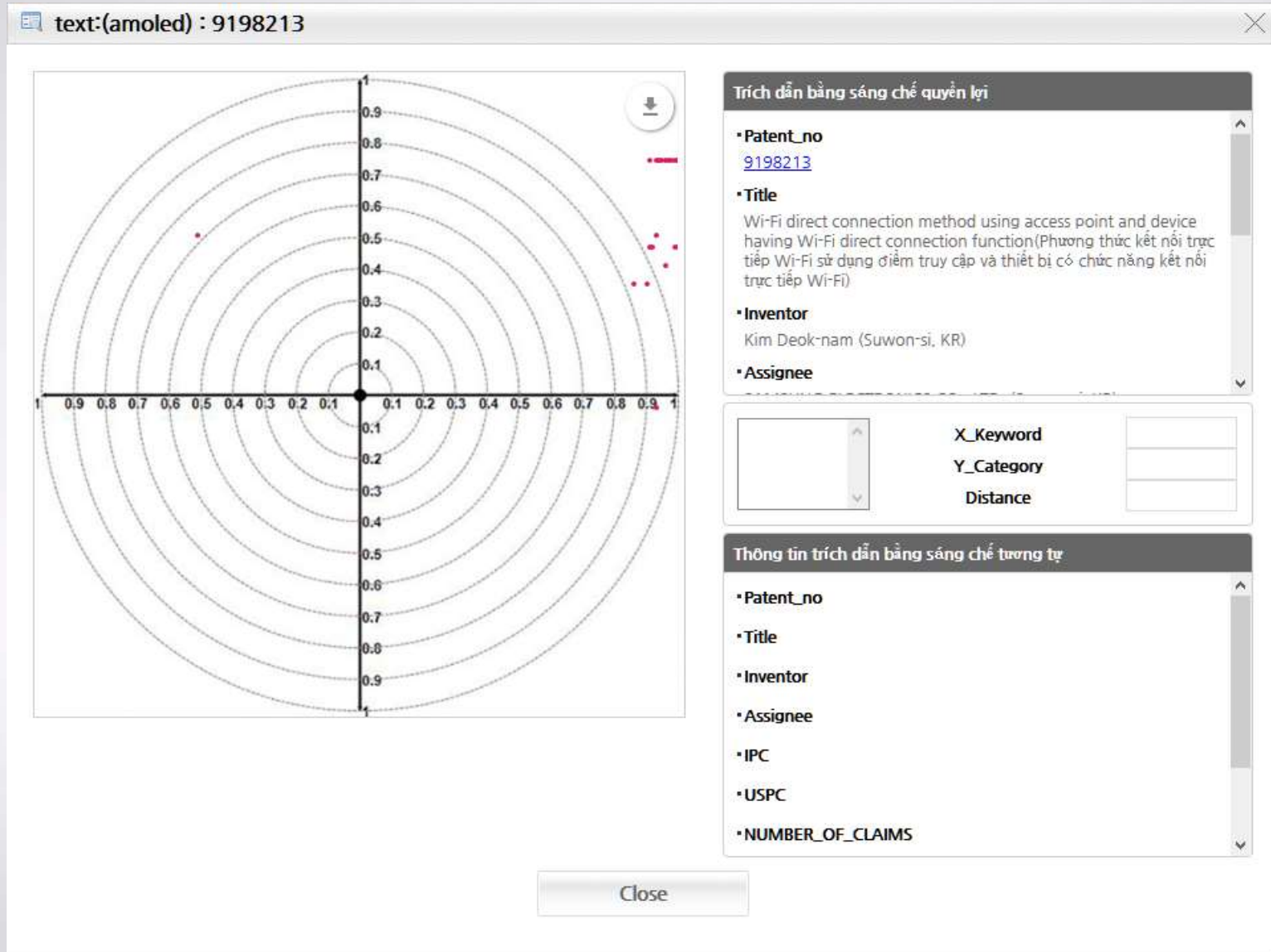
Mô hình này có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau như điều tra bằng sáng chế đã có, xác định sự trùng lặp kết quả nghiên cứu bằng sáng chế, phân tích so sánh đối thủ cạnh tranh và bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh, tính mới của công nghệ và đánh giá / chẩn đoán công nghệ sáng tạo.



<Màn hình ví dụ về khả năng vi phạm bằng sáng chế>

5. DEMO (Potential Patent Infringement)

Similar patent



5. DEMO (Potential Patent Infringement)

Report

Mục lục +

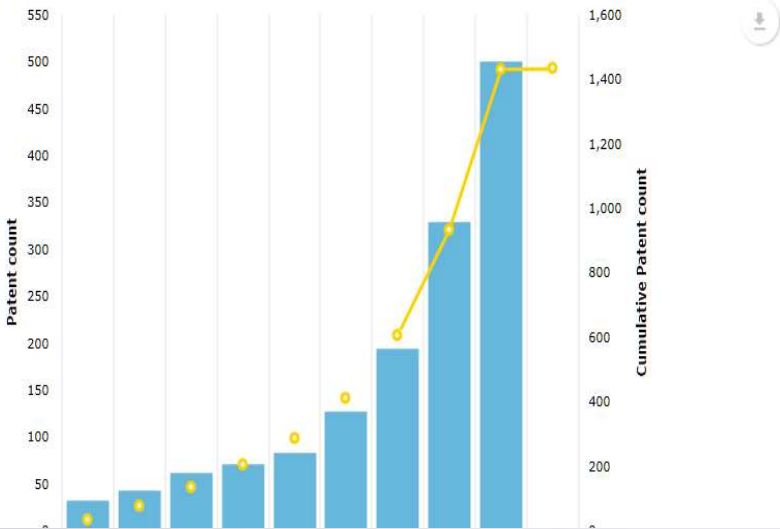
1. Điều kiện tìm kiếm

Trong phân tích này, dữ liệu bằng sáng chế của Mỹ đã được sử dụng, và truy vấn tìm kiếm là để tìm kiếm bằng sáng chế.

text(amoled)
Tổng số bằng sáng chế được trích là 1431, và số bằng sáng chế hàng năm như sau.

Bảng 1-1. Số bằng sáng chế với năm xuất bản

năm	Số bằng sáng chế	Số bằng sáng chế cộng dồn
2007	31	31
2008	42	73
2009	60	133
2010	70	203
2011	81	284
2012	126	410
2013	193	603
2014	328	931
2015	499	1,430
2016	1	1,431



2. Khám phá các bằng sáng chế tương tự

(Trục X), và cách thức phân loại bằng sáng chế được cấp cho mỗi bằng sáng chế là như thế nào, trục Y).
Bảng 2-2 cho thấy thông tin thư mục ngắn của 50 bằng sáng chế hàng đầu cho thấy mức độ tương đồng cao với các bằng sáng chế quan tâm.

Bảng 2-1. Bảng độc quyền sáng chế (bằng sáng chế gốc)

Số bằng sáng chế	Tiêu đề bằng sáng chế	Người nộp đơn	Yêu cầu bồi thường
9198213	Wi-Fi direct connection method using access point and device having Wi-Fi direct connection function(Phương thức kết nối trực tiếp Wi-Fi sử dụng điểm truy cập và thiết bị có chức năng kết nối trực tiếp Wi-Fi)	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (Suwon-si, KR)	12

Bảng 2-2. Top 50 danh sách các bằng sáng chế tương tự (bằng sáng chế cạnh tranh)

Số	Số bằng sáng chế	Tiêu đề bằng sáng chế	Người nộp đơn	Yêu cầu bồi thường	Khoảng cách đo lường tương tự
1	9100944	Wireless connecting mobile devices and wearable devices(Kết nối thiết bị di động và thiết bị có thể đeo không dây)	QUALCOMM Incorporated (San Diego, CA, US)	24	0.77
2	8489076	Method and apparatus for contact information management in mobile terminal(Phương pháp và thiết bị quản lý thông tin liên lạc trong terminal di động)	Samsung Electronics Co., Ltd. (Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR)	19	0.89
3	9078087	Method and apparatus for forming Wi-Fi P2P group using Wi-Fi direct(Phương pháp và thiết bị để tạo nhóm Wi-Fi P2P sử dụng Wi-Fi trực tiếp)	Samsung Electronics Co., Ltd. (Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR)	26	0.90
4	9055391	Method and apparatus for discovering device in wireless communication network(Phương pháp và thiết bị để phát hiện thiết bị trong mạng truyền thông không dây)	Samsung Electronics Co., Ltd. (Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR)	19	0.93
5	8774802	Method and apparatus for EPLMN list management in mobile terminal(Phương pháp và thiết bị quản lý danh sách EPLMN trong nhà ga di động)	Samsung Electronics Co., Ltd. (Suwon-si, KR)	20	0.97
6	8934841	Bluetooth communication method and system (Phương pháp truyền thông Bluetooth và hệ thống)	Samsung Electronics Co., Ltd. (Suwon-si, KR)	19	1.02
7	8954003	System and method of managing pairing information associated with peer-to-peer device pairings(Hệ thống và phương pháp quản lý thông tin ghép nối liên kết thiết bị giữa các đồng nghiệp)	Blackberry Limited (Waterloo, CA)	19	1.02
		Short range wireless communication apparatus			

5. DEMO (Trade Scan)

Introduction

Tìm kiếm thương mại

 Giới thiệu



Tìm các mặt hàng phụ thuộc



Tìm các mặt hàng xuất khẩu chính



Chẩn đoán tình trạng xuất nhập khẩu



Thông tin HS thế giới

Mô hình này cung cấp thông tin thương mại (xuất nhập khẩu) toàn cầu về tất cả các mặt hàng trong 5 năm gần nhất.

Tất cả các mặt hàng đã được giao dịch với Hàn Quốc trong 5 năm gần đây dựa trên Bộ luật HS (Hệ thống mã hoá hài hoà và mô tả hàng hóa) do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) thiết lập là chủ đề của phân tích mô hình này.

Bạn có thể chỉ định mặt hàng theo hai cách: bằng cách nhập mã HS trực tiếp dưới dạng 6 chữ số hoặc bằng cách chọn mã HS từ kết quả tìm kiếm các mặt hàng có lượng giao dịch lớn hơn điều kiện tìm kiếm (lượng xuất nhập khẩu theo USD) xác định bởi người sử dụng. Đối với mặt hàng được chỉ định, mô hình này cung cấp các kết quả phân tích sau đây.

Các kết quả phân tích có thể tìm thấy trên trang web của COMPAS, hoặc có thể được lưu dưới dạng báo cáo riêng.

- Thống kê thương mại như là
 - Đơn giá giao dịch hàng năm
 - Lượng hàng giao dịch hàng năm
 - Tình trạng Xuất / Nhập khẩu theo Quốc gia mục tiêu
 - Chỉ số Chuyên ngành Thương mại
 - Độ tập trung xuất khẩu
 - Phân tích chéo thặng dư xuất khẩu

Bằng cách hiểu được tình hình thương mại trong và ngoài nước của các mặt hàng quan tâm, người dùng sẽ có thể tìm được thị trường mới, như tìm kiếm các sản phẩm thương mại mới, hỗ trợ các chiến lược phát triển công nghệ và các cơ hội công nghệ liên quan đến nhu cầu thị trường, thay thế nhập khẩu và tìm các mặt hàng xuất khẩu chính.

5. DEMO (Competitor Identifier)

Introduction

Nhận dạng đối thủ cạnh tranh



Giới thiệu



Workbench



Dự án

Khi lập kế hoạch R & D cho TOI, điều đầu tiên cần làm là đạt được một 'bức tranh chung' của TOI và xác định được các đối thủ cạnh tranh chính.

Chức năng "Nhận dạng đối thủ cạnh tranh" là mô hình phù hợp nhất cho mục đích này. Mô hình này cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hoạt động R & D trong một TOI như số lượng bằng sáng chế (với năm xuất bản) và thị phần của các bằng sáng chế của người chủ sở hữu (đối thủ cạnh tranh) và các nước sở hữu.

Mô hình cũng cung cấp các chỉ số, dựa trên mức trích dẫn bằng sáng chế và quy mô của họ các bằng sáng chế, để phân tích chất lượng của bộ bằng sáng chế của những người sở hữu chính (và các nước sở hữu).

Một danh sách các bằng sáng chế được trích dẫn cao trong một TOI cũng được đưa ra. Cùng với các chỉ số đã đề cập ở trên, một danh sách các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, top 30 người chủ sở hữu với số lượng bằng sáng chế cao nhất, được cung cấp ở cuối mô hình.

Các chỉ số được cung cấp bởi mô hình này như sau:

- Tổng số bằng sáng chế với năm xuất bản
- Số bằng sáng chế của người sở hữu và nước sở hữu (năm xuất bản)
- Chất lượng bằng sáng chế (yếu tố Q và quy mô họ sáng chế trung bình) đối với người sở hữu và nước sở hữu
- Số bằng sáng chế của người nhận chuyển nhượng Việt Nam (với năm xuất bản)
- Chất lượng sáng chế (Q-factor) đối với người sở hữu của Việt Nam
- Đối thủ cạnh tranh tiềm năng chính
- Bằng sáng chế được trích dẫn cao



Sample Report

5. DEMO (Competitor Identifier)

Report

Table of contents



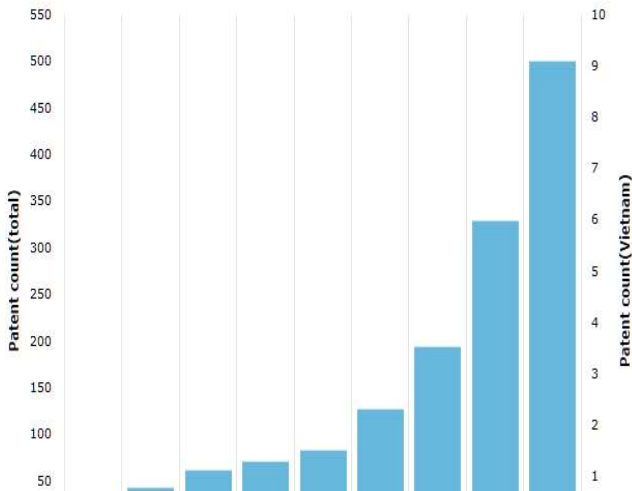
Điều kiện tìm kiếm

Phân tích này được thực hiện trên các khoản trợ cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu tìm kiếm công nghệ được quan tâm. PATSTAT (Cơ quan Sáng chế châu Âu) đã được sử dụng để lấy thông tin gia đình về các bằng sáng chế. Truy vấn tìm kiếm để xác định công nghệ được quan tâm như sau:
text:(amoled)
Khoảng thời gian tìm kiếm được đặt thành 2007-2015. Số lượng bằng sáng chế cho phân tích là 1430.

1. Bảng sáng chế với năm xuất bản

Bảng 1. Số bằng sáng chế với năm xuất bản

Năm	Số bằng sáng chế	Số bằng sáng chế (tích lũy)	Số bằng sáng chế của người Korea, Republic
2007	31	31	0
2008	42	73	0
2009	60	133	0
2010	70	203	0
2011	81	284	0
2012	126	410	0
2013	193	603	0
2014	328	931	0
2015	499	1,430	0

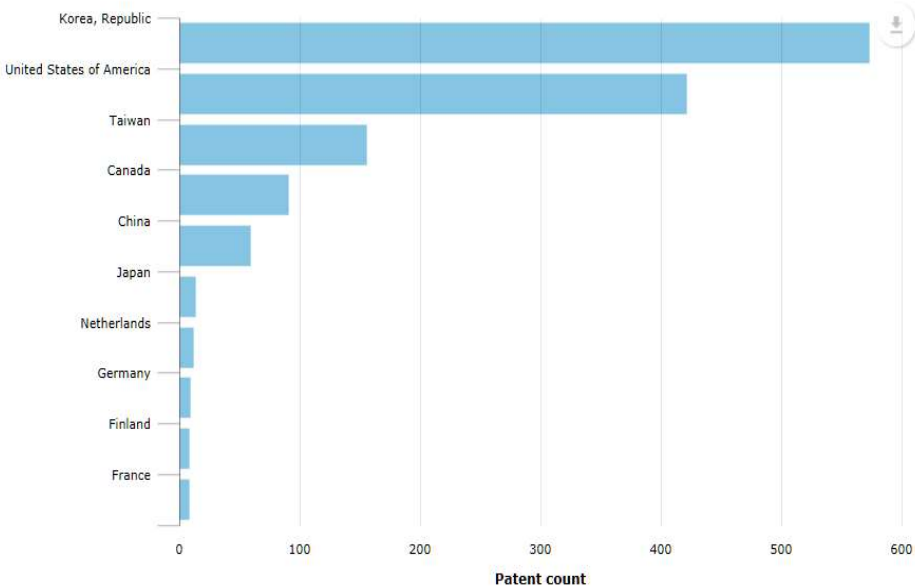


2. Phân tích quốc gia được phân bổ

2-1. Số bằng sáng chế của 10 nước được chuyển nhượng hàng đầu

Bảng 2. Số lượng bằng sáng chế của 10 nước được chuyển nhượng hàng đầu

Xếp hạng	Nước nhận chuyển nhượng	Số bằng sáng chế	Chia sẻ (%)
1	Korea, Republic	573	40.07
2	United States of America	421	29.44
3	Taiwan	155	10.84
4	Canada	90	6.29
5	China	59	4.13
6	Japan	13	0.91
7	Netherlands	11	0.77
8	Germany	9	0.63
9	Finland	8	0.56
9	France	8	0.56



Hình 2. Số lượng bằng sáng chế của 10 nước được chuyển nhượng hàng đầu

- Korea, Republic đã xuất bản 573 bằng sáng chế chiếm phần lớn nhất (40.07%) trong tổng số.
- Các quốc gia sau đây như United States of America và Taiwan xuất bản 421 và 155 bằng sáng chế chiếm 29.44 và 10.84% tổng số.
- Korea, Republic đã xuất bản 573 bằng sáng chế chiếm 40.07% tổng số và xếp hạng ở mức 1st.

5. DEMO (Promising Patent Technologies)

Introduction

Chú ý thăm dò công nghệ

 Giới thiệu	 Chỉ định nhóm công nghệ	 Dự án
--	---	---

Mục đích của mô hình này là cung cấp cho người sử dụng một lĩnh vực công nghệ đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu gần đây bằng cách nhóm (clustering) danh sách các bằng sáng chế.

Trong những năm gần đây, một danh sách các cụm dựa trên tính tương đồng giữa các bằng sáng chế đã được xây dựng trên COMPAS như một cơ sở dữ liệu công nghệ đáng chú ý cho các danh sách bằng sáng chế cho các bằng sáng chế cao.

Người sử dụng có thể tìm kiếm trong danh sách các lĩnh vực quan tâm bằng cách áp dụng một công thức tìm kiếm cho DB của sự quan tâm được thành lập trong COMPAS.

Trường công nghệ mà mô hình được áp dụng đề cập đến một bộ các bằng sáng chế được chỉ định bởi người dùng. Sử dụng chức năng tìm kiếm bằng sáng chế COMPAS, người dùng có thể tìm kiếm lĩnh vực công nghệ mà họ quan tâm, và kết quả tìm kiếm được lưu trữ trong COMPAS. Trong quá trình thực hiện mô hình, người dùng chỉ định kết quả tìm kiếm như là một bộ bằng sáng chế sẽ được sử dụng để phân tích.

Khi người dùng chỉ định một lĩnh vực công nghệ cụ thể và yêu cầu phân tích, mô hình này so sánh danh sách bằng sáng chế trong lĩnh vực kỹ thuật được chỉ định bởi người sử dụng với danh sách bằng sáng chế trong DB công nghệ nổi bật. Nếu có một công nghệ đáng chú ý bao gồm một hoặc nhiều bằng sáng chế của bằng sáng chế của người dùng, hãy cung cấp một danh sách các tính năng đó.

Người dùng có thể xác định các xu hướng trong các chủ đề nghiên cứu bằng cách xác định các lĩnh vực công nghệ gần đây trong lĩnh vực công nghệ và sử dụng chúng để đặt ra các hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

 Sample Report

5. DEMO (Promising Patent Technologies)

Report

> Định nghĩa của mục tiêu phân tích	> Tên dự án	text:(nano)
	> Cụm từ tìm kiếm	text:(nano)
	> Ngày tìm kiếm	2017-06-15
	> Tìm kiếm	69396
	> Thời gian tìm kiếm	1991 ~ 2017
> Cluster DB Mô tả	> Thời gian mục tiêu	2012 ~ 2014
	> Phạm vi đích	5% đầu trang theo số lượng trích dẫn, 1 trích dẫn trở lên
	> Phương pháp phân nhóm	BACKWARD CITATION 기준 COSINE도량 sự giống nhau
	> Tiêu chuẩn tương tự	0.1
	> Dựa trên kích thước cluster	10trở lên và 50hoặc ít hơn

	2012	2013	2014
39	1	1	0
23	0	1	0
22	0	1	0
19	1	0	0
18	0	1	0
16	1	0	0
15	0	1	1
13	1	0	1
12	0	1	0
11	0	0	1
10	0	3	0

Số sê ri	39_2012_1			
Tổng quan về kỹ thuật				
Phân loại IPC	H01L(82.5%) , G06F(17.5%)			
Phân loại ngành liên quan	반도체웨이퍼 관련(82.5%) , 전자계산기 (17.5%)			
Thông tin thống kê	Số bảng sáng chế cơ bản	Tổng số bảng sáng chế cho các bảng sáng chế then chốt	Số bảng sáng chế đối với mỗi bảng sáng chế cơ bản	Năm trung bình các bảng sáng chế quan trọng
	39	2014	51.67	2012.3

Bảng sáng chế chính

[2012]	8129750	92	Integrated circuit including at least six linear-shaped conductive structures forming gate electrodes of transistors with at least two linear-shaped conductive structures of different length
[2012]	8129751	86	Integrated circuit including at least six linear-shaped conductive structures forming gate electrodes and including four conductive contacting structures having at least two different connection distances
[2012]	8129752	87	Integrated circuit including a linear-shaped conductive structure forming one gate electrode and having length greater than or equal to one-half the length of linear-shaped conductive structure forming two gate electrodes
[2012]	8129754	86	Integrated circuit with gate electrode level including at least six linear-shaped conductive structures forming gate electrodes of transistors with at least one pair of linear-shaped conductive structures having offset ends
[2012]	8129755	86	Integrated circuit with gate electrode level including at least four linear-shaped conductive structures of equal length and equal pitch with linear-shaped conductive structure forming one transistor
[2012]	8129756	86	Integrated circuit including at least six linear-shaped conductive structures forming gate electrodes of transistors with at least two different extension distances beyond conductive contacting structures
[2012]	8129757	86	Integrated circuit including at least six linear-shaped conductive structure structures at equal pitch including at least two linear-shaped conductive structures having non-gate portions of different length
[2012]	8129819	84	Method of fabricating integrated circuit including at least six linear-shaped conductive structures at equal pitch including at least two linear-shaped conductive structures having non-gate portions of different length
[2012]	8134183	86	Integrated circuit including linear-shaped conductive structures that have gate portions and extending portions of different size
[2012]	8134184	125	Integrated circuit having gate electrode level region including at least four linear-shaped conductive structures with some outer-contacted linear-shaped conductive structures having larger outer extending portion than inner extending portion
[2012]	8134185	86	Integrated circuit having gate electrode level region including at least seven linear-shaped conductive structures at equal pitch including linear-shaped conductive structure forming transistors of two different types and at least three linear-shaped conductive structures having aligned ends
[2012]	8134186	86	Integrated circuit including at least three linear-shaped conductive structures at equal pitch including linear-shaped conductive structure having non-gate portion length greater than gate portion length
[2012]	8138525	86	Integrated circuit including at least three linear-shaped conductive structures of different length each forming gate of different transistor
[2012]	8198656	84	Integrated circuit including gate electrode level region including at least four linear-shaped conductive structures of equal length having aligned ends and positioned at equal pitch and forming multiple gate electrodes of transistors of different type
[2012]	8207053	84	Electrodes of transistors with at least two linear-shaped conductive structures of different length
[2012]	8214778	88	Methods for cell phasing and placement in dynamic array architecture and implementation of the same
[2012]	8217428	88	Integrated circuit including gate electrode level region including at least three linear-shaped conductive structures of equal length having aligned ends and positioned at equal pitch and forming multiple gate electrodes of transistors of different type
[2012]	8225239	93	Methods for defining and utilizing sub-resolution features in linear topology
[2012]	8225261	88	Methods for defining contact grid in dynamic array architecture

5. DEMO (Competitor Profile)

Introduction

Hồ sơ đối thủ cạnh tranh



Giới thiệu



Đối thủ cạnh tranh



Dự án

Mô hình này cung cấp một bản mô tả chi tiết các hoạt động sáng chế của các đối thủ cạnh tranh chính được chỉ định bởi người sử dụng trong số các đối thủ cạnh tranh (những người chủ sở hữu) thuộc một lĩnh vực công nghệ cụ thể.

Để chạy mô hình này, mô hình "Nhận dạng đối thủ cạnh tranh" do COMPAS cung cấp phải được tiến hành trước để có được danh sách các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Trong quá trình thực hiện mô hình này, người sử dụng cần chọn một dự án cụ thể của "Nhận dạng đối thủ cạnh tranh" và chọn đối thủ cạnh tranh chính để tạo hồ sơ (portfolio).

Đối với các đối thủ cạnh tranh chính do người sử dụng lựa chọn, mô hình này phân tích và cung cấp các hồ sơ sáng chế như sau. Các kết quả có thể được xem trên trang web COMPASS cũng như dưới dạng các báo cáo riêng biệt.

- Phân tích IPC theo đối thủ cạnh tranh
- Phân tích USPC theo đối thủ cạnh tranh
- Phân tích các nước nộp đơn theo đối thủ cạnh tranh
- Phân tích nhà phát minh theo đối thủ cạnh tranh
- Danh sách bằng sáng chế chính theo đối thủ cạnh tranh

Người sử dụng có thể phân tích hồ sơ chi tiết của từng đối thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực kỹ thuật quan tâm, từ đó xác định lĩnh vực công nghệ chính, lĩnh vực thương mại hóa chủ yếu và tình trạng của nhà phát minh chính của mỗi đối thủ cạnh tranh. Các kết quả của phân tích này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc định hướng R & BD và so sánh các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ quan tâm.

Như đã đề cập ở trên, để áp dụng mô hình này, mô hình "Nhận dạng đối thủ cạnh tranh" được cung cấp bởi COMPAS phải được tiến hành trước tiên.



Sample Report



5. DEMO (Competitor Profile)

Report

Table of contents +

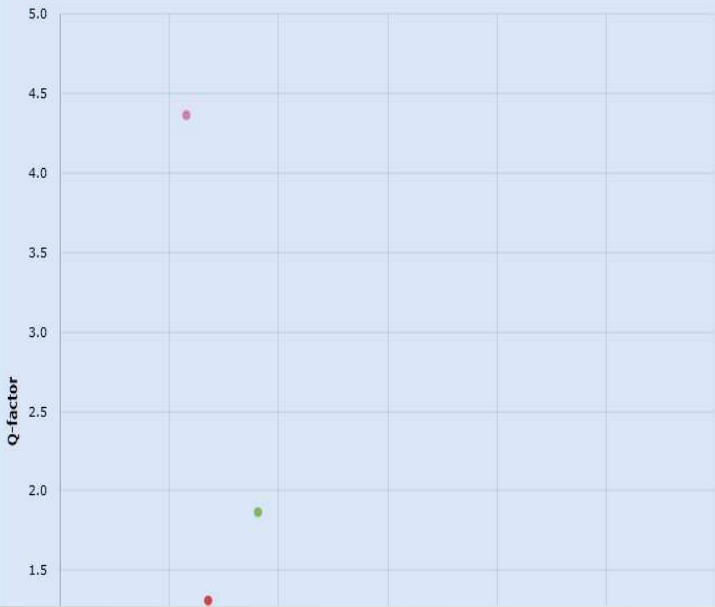
Điều kiện tìm kiếm

Trong phân tích này, cơ sở dữ liệu Patent và PATSTAT của Mỹ được sử dụng. Truy vấn tìm kiếm bằng sáng chế cho công nghệ được quan tâm như sau.
text:(amoled)

Danh sách đối thủ cạnh tranh

Bảng 1. Số lượng bằng sáng chế và yếu tố Q của các đối thủ cạnh tranh chính

Mục lục	Đối thủ chính	Số bằng sáng chế	Q-factor	Quy mô gia đình trung bình so với trung bình hiện trường
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	256	0.421	1.028
2	SAMSUNG DISPLAY CO LTD	103	0.195	0.917
3	GOOGLE INC	91	1.864	1.16
4	SAMSUNG MOBILE DISPLAY CO LTD	68	1.31	1.284
5	IGNIS INNOVATION INC	58	4.357	1.703



1. Phân tích IPC theo đối thủ cạnh tranh

1-1. Trạng thái IPC theo đối thủ cạnh tranh (toàn diện)

Bảng 2. Trạng thái IPC theo đối thủ cạnh tranh

IPC	Số bằng sáng chế của tất cả những người được chuyển giao trong lĩnh vực công nghệ	Tổng số bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh chính	Chia sẻ bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh chính(%)	Đối thủ chính				
				1	2	3	4	5
Total	1,929	820	42.51	410	132	135	73	71
G09G	404	160	39.6	32	59	9	9	51
G06F	303	139	45.87	72	10	45	2	10
H01L	340	101	29.71	33	37	0	26	6
H04W	85	62	72.94	49	0	13	0	0
H04M	83	56	67.47	48	0	8	0	0
H04N	85	39	45.88	38	1	0	0	0
H01J	78	35	44.87	2	7	0	26	0
H04B	39	28	71.79	25	0	3	0	0
H04L	47	25	53.19	15	0	10	0	0
G06K	40	16	40	11	0	5	0	0
G01C	25	15	60	7	0	8	0	0
H05B	53	12	22.64	1	4	0	6	1
G11C	22	10	45.45	9	1	0	0	0
G10L	10	10	100	3	0	7	0	0
G06T	23	7	30.43	2	1	4	0	0
H03K	12	7	58.33	4	1	0	1	1
G02F	45	7	15.56	2	3	1	1	0
G01S	7	5	71.43	5	0	0	0	0
G08C	5	5	100	4	0	1	0	0
H04R	6	5	83.33	5	0	0	0	0
H04K	8	5	62.5	2	0	3	0	0
G03B	9	4	44.44	4	0	0	0	0
B60Q	6	4	66.67	0	0	4	0	0
G08B	8	4	50	2	0	2	0	0
H01R	4	4	100	4	0	0	0	0
H01Q	7	4	57.14	4	0	0	0	0
G01R	15	4	26.67	1	0	1	0	2
G06Q	21	3	14.29	2	0	1	0	0
H05K	22	3	13.64	2	1	0	0	0
G08G	6	3	50	0	0	3	0	0

5. DEMO (Patent Citation Tree)

Introduction

Phân tích trích dẫn

 Giới thiệu

 Tìm kiếm thông tin trích dẫn

 Dự án

Mô hình này phân tích và giám sát thông tin trích dẫn bởi (Backward Citation) và trích dẫn tới (Forward Citation) bằng sáng chế quan tâm (POI).

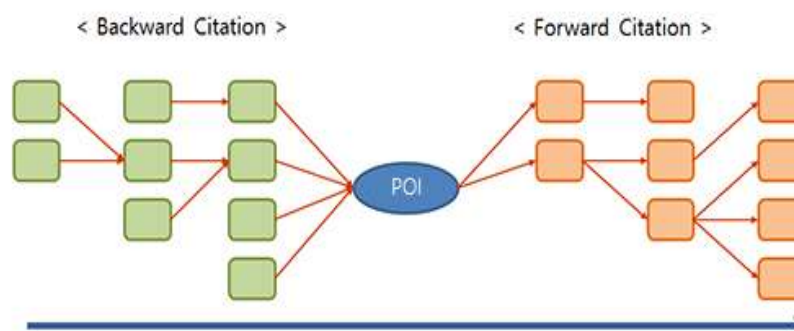
Trong mô hình này, kết quả phân tích bằng sáng chế trích dẫn được thể hiện dưới dạng một cây trích dẫn để người sử dụng dễ dàng nắm bắt được kết quả. Ngoài ra, khi bằng sáng chế quan tâm (POI) được đăng ký trong dự án, các trích dẫn mới tới bằng sáng chế này sẽ được quản lý bởi mô hình và cảnh báo tới người sử dụng.

Các phân tích chính được cung cấp bởi mô hình này như sau.

- Cây Trích dẫn: biểu diễn các trích dẫn backward và forward tới 3 mức và cho lọc theo loại trích dẫn (backward và forward), mức trích dẫn, thời gian v.v...
- Danh sách sáng chế: danh sách các sáng chế trong cây trích dẫn với các thuộc tính như số bằng sáng chế, IPC, chủ sở hữu, phân loại trích dẫn, trích dẫn backward và forward, mức trích dẫn v.v.. Thống kê: phân tích thống kê về các sáng chế trong cây trích dẫn với các mục phân tích như danh sách các trích dẫn tới (forward), phân bố theo thời gian, chủ sở hữu v.v...

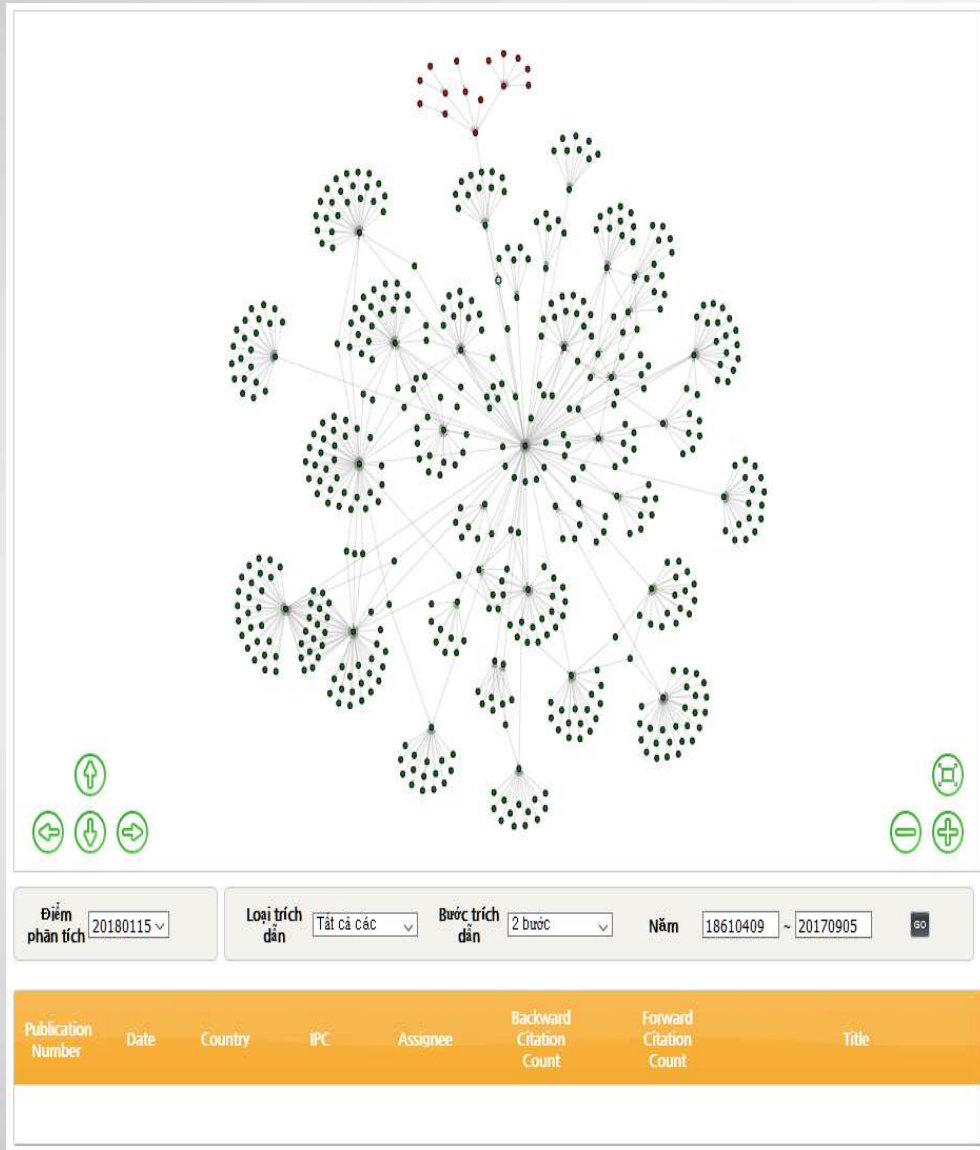
Các trích dẫn bởi sáng chế (backward citation) trong mô hình này có thể được sử dụng để xác định các sáng chế mới nhất trước sáng chế quan tâm, trong khi đó trích dẫn tới (forward citation) có thể được dùng để tìm kiếm các đối thủ/đối tác tiềm năng. Các ứng dụng khác có thể kể bao gồm xác định vi phạm sáng chế hoặc nghiên cứu thị trường công nghệ

 Sample Report



5. DEMO (Patent Citation Tree)

Citation tree



Publication Number	Date	Country	IPC	Assignee	Backward Citation Count	Forward Citation Count	Title	Category Citation	Citation Type	Citation Step
1071354	19130826	US		FRIEDRICH OSCAR SCHNELLE	-	-	ELECTRICAL SEPARATOR.	APP	Back ward	2Step
1337488	19200420	US	B03C003/36	RESEARCH CORPORATION	-	-	Method of regulating the velocity of fumes passing through electrical precipitators	SEA	Back ward	2Step
1379056	19210524	US	B01D045/02	THE GAS RESEARCH COMPANY	-	-	Purification of gas	SEA	Back ward	2Step
1411796	19220404	US	G01F001/64	THE CUTLERHAMMER MFG. CO.	-	-	Method of and apparatus for measuring the flow of fluids	SEA	Back ward	2Step
1579462	19260406	US	B03C003/80	RESEARCH CORPORATION	-	-	Method of and apparatus for separating light materials from gases	SEA	Back ward	2Step
1605648	19261102	US	B03C003/12	COOKE MILTON W	-	-	Art of separating suspended matter from gases	SEA	Back ward	2Step
1740462	19291224	US	G01N001/34	CUTLER-HAMMER, INC.	-	-	Method of conditioning fluids	SEA	Back ward	2Step
1796110	19310310	US	B01J019/08	INTERNATIONAL PRECIPITATION COMPANY	-	-	Process and apparatus for effecting chemical reactions between gases	SEA	Back ward	2Step
1801515	19310421	US	B03C003/60	INTERNATIONAL PRECIPITATION COMPANY	-	-	Apparatus for electrical treatment of gases containing corrosive material and mercury	SEA	Back ward	2Step
1849198	19320315	US	C10C001/14	THE BARRETT COMPANY	-	-	Method of preparing creosoting compositions and apparatus therefor	SEA	Back ward	2Step



5. DEMO (Patent Citation Tree)

Report

Mục lục

- 1. Danh sách bằng sáng chế cho trích dẫn mới
- 2. Phân phát bằng sáng chế theo năm
- 3. Phân phối người đăng ký
- 4. Phân phối IPC

1. Danh sách bằng sáng chế cho trích dẫn mới

Bảng 1. Danh sách trích dẫn bằng sáng chế mới

Số bằng sáng chế	Ngày cấp bằng sáng chế	Tên sáng chế	Người nộp đơn	IPC	Phân loại	Citation Category
Không có thông tin như vậy trong phân tích này.						

2. Distribution of patents by year

Xu hướng áp dụng bằng sáng chế theo năm.

2. Phân phát bằng sáng chế theo năm

Năm	Số bằng sáng chế	Số bằng sáng chế cộng dồn
1913	1	1
1920	1	2
1921	1	3
1922	1	4
1926	2	6
1929	1	7
1931	2	9
1932	2	11
1934	1	12
1935	1	13
1937	1	14
1938	1	15
1939	1	16

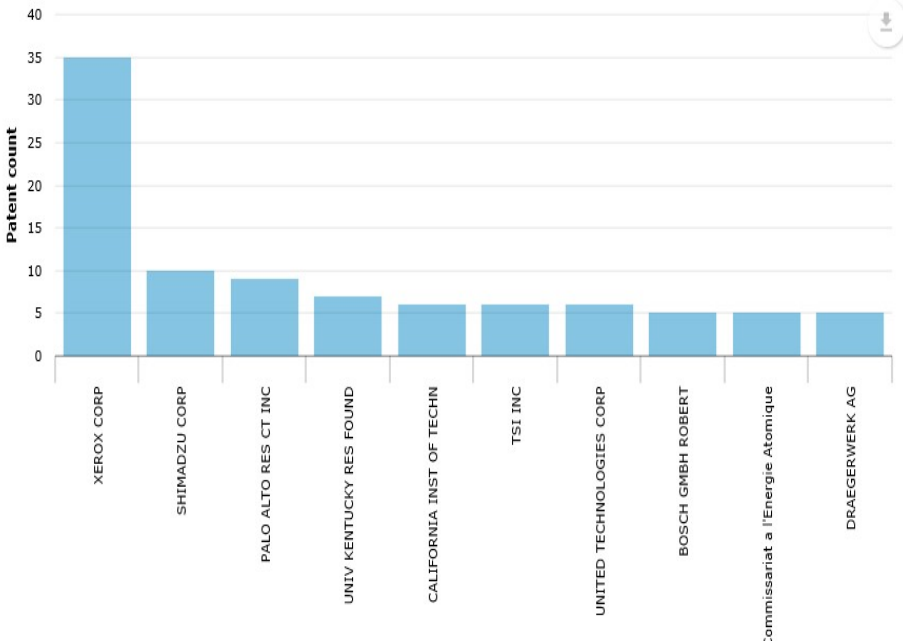
3. Phân phối người đăng ký

Phân phối các ứng viên chính.

Display : 10

Bảng 3. Số lượng sáng chế của người nộp đơn

Số	Người nộp đơn	Số bằng sáng chế
1	XEROX CORP	35
2	SHIMADZU CORP	10
3	PALO ALTO RES CT INC	9
4	UNIV KENTUCKY RES FOUND	7
5	CALIFORNIA INST OF TECHN	6
6	TSI INC	6
7	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6
8	BOSCH GMBH ROBERT	5
9	Commissariat a l'Energie Atomique	5
10	DRAEGERWERK AG	5



5. DEMO (Tech Tree)

Introduction

Cây công nghệ



Giới thiệu



Chỉ định nhóm công nghệ



Dự án

Mô hình này nhằm xác định các công nghệ phụ trợ liên quan tới công nghệ được quan tâm (TOI) và đưa ra thông tin chi tiết của các công nghệ phụ trợ lựa chọn bởi người sử dụng. Việc phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng Phân loại Sáng chế Quốc tế (IPC) do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đưa ra. Phân loại bằng sáng chế quốc tế có phân cấp của các phần, các lớp, các lớp con, các nhóm chính và các phân nhóm con.

TOI liên quan đến một bộ các bằng sáng chế được chỉ định bởi người dùng. Sử dụng chức năng tìm kiếm bằng sáng chế COMPAS, người dùng có thể tìm kiếm lĩnh vực công nghệ mà họ quan tâm, và kết quả tìm kiếm được lưu trữ trong COMPAS. Trong quá trình thực thi mô hình, người dùng có thể lấy các kết quả tìm kiếm là các bằng sáng chế để phân tích.

Khi người dùng chỉ định một lĩnh vực công nghệ cụ thể và thực hiện phân tích, một danh sách các công nghệ chi tiết cấu thành công nghệ (IPC) được cung cấp. Danh sách này được tạo thành từ nhóm chính của IPC, nhóm này có thể được mở rộng tới các nhóm con bên dưới theo phân cấp.

Người dùng có thể chỉ định các mô tả chi tiết (IPC) để phân tích chi tiết với các mục phân tích như sau:

- Tình trạng hoạt động bằng sáng chế của các IPC chính và IPC quan tâm
- Hoạt động sáng chế của các người sở hữu chính theo IPC và IPC quan tâm
- Hoạt động của người nộp đơn Hàn Quốc theo IPC quan tâm
- Khám phá các IPC có liên quan đến IPC quan tâm



Sample Report

5. DEMO (Tech Tree)

Report

Classification	Description
▲ ☐ H01L029/00 (83, 60.58%)	Semiconductor devices specially adapted for rectifying, amplifying, oscillating or switching and having at least one potential-jump barrier or surface barrier;Capacitors or resistors with at least one potential-jump barrier or surface barrier, e.g. PN-junction depletion layer or carrier concentration layer;Details of semiconductor bodies or of electrodes thereof(H01L031/00 to H01L047/00, H01L051/05 take precedence);processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof H01L021/00;details other than of semiconductor bodies or of electrodes thereof H01L023/00;devices consisting of a plurality of solid state components formed in or on a common substrate H01L027/00;resistors in general H01C;capacitors in general H01G)
▲ ☐ H01L021/00 (36, 26.28%)	Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof(processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of devices provided for in groups H01L031/00 to H01L051/00 or of parts thereof, see these groups;single-step processes covered by other subclasses, see the relevant subclasses, e.g. C23C, C30B;photomechanical production of textured or patterned surfaces, materials or originals thereof, apparatus specially adapted therefor, in general G03F)
▼ ☐ H01L033/00 (18, 13.14%)	Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission, e.g. infra-red;Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof;Details thereof (H01L051/50 takes precedence);devices consisting of a plurality of components formed in or on a common substrate H01L027/00;couplings of light guides with optoelectronic elements G02B006/42;semiconductor lasers H01S005/00;electroluminescent light sources per seH05B033/00)
▲ ☐ H01L027/00 (14, 10.22%)	Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate (processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof H01L021/70, H01L031/00 to H01L051/00;details thereof H01L023/00, H01L029/00 to H01L051/00;assemblies consisting of a plurality of individual solid state devices H01L025/00;assemblies of electrical components in general H05K)
▲ ☐ H01L031/00 (14, 10.22%)	Semiconductor devices sensitive to infra-red radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength, or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation;Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof;Details thereof(H01L051/42 takes precedence);devices consisting of a plurality of solid state components formed in, or on, a common substrate, other than combinations of radiation-sensitive components with one or more electric light sources, H01L027/00;roof covering aspects of energy collecting devices E04D013/18;production of heat using solar heat F24J002/00;measurement of X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation or cosmic radiation with semiconductor detectors G01T001/24, with resistance detectors G01T001/26;measurement of neutron radiation with semiconductor detectors G01T003/08;couplings of light guides with optoelectronic elements G02B006/42;obtaining energy from radioactive sources G21H)
▲ ☐ H01L023/00 (13, 9.49%)	Details of semiconductor or other solid state devices(H01L025/00 takes precedence)
▲ ☐ C30B025/00 (7, 5.11%)	Single-crystal growth by chemical reaction of reactive gases, e.g. chemical vapour deposition growth
▲ ☐ H01J001/00 (7, 5.11%)	Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps(details of electron-optical arrangements or of ion traps H01J003/00)
▲ ☐ H03K017/00 (6, 4.38%)	Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and -breaking(selection of the stylus or auxiliary electrode in electric printing B41J002/405;sample-and-hold arrangements G11C027/02;switching or interrupting devices in waveguides H01P;gated amplifiers H03F003/72;switching arrangements for exchange systems using static devices H04Q003/52)
▲ ☐ C30B029/00 (5, 3.65%)	Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape(alloys C22C)

Mục lục



Điều kiện tìm kiếm

- Trong phân tích này, cơ sở dữ liệu patent đã đăng ký ở Mỹ đã được sử dụng, và công thức tìm kiếm để tìm kiếm bằng sáng chế trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan như sau. Số lượng bằng sáng chế đã truy lục là 137.

in:(Mishra AND Umesh)

0. Ghi chú

- Nhìn chung, bằng sáng chế được phân công một loạt các IPC (Phân loại bằng sáng chế quốc tế), có nghĩa là một mô tả chi tiết tạo thành một sáng chế được biết đến trong bằng sáng chế.
- Mô hình này phân tích IPC được giao cho một bằng sáng chế trong một lĩnh vực công nghệ cụ thể được xác định bởi công thức tìm kiếm, nhằm mục đích nắm bắt công nghệ chi tiết hiện có trong lĩnh vực công nghệ có liên quan và mối quan hệ giữa chúng.
- Trong mô hình này, tất cả các phân tích được thực hiện ở cấp nhóm chính của IPC, và nhóm chính có dạng A00A000.

1. Phân tích topo IPC

- Bằng cách xác định vị trí tương đối giữa các IPC lớn và IPC quan tâm trong lĩnh vực công nghệ, có thể xác định nơi IPC quan tâm được đặt trong lĩnh vực công nghệ.

1-1. Bằng sáng chế đăng ký theo IPC lớn

- Cung cấp 10 IPC hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ dựa trên số bằng sáng chế, để họ có thể xác định những chi tiết chính của công nghệ.
- Ngoài ra, người dùng có thể chỉ định các IPCs quan tâm để xác định các giai đoạn tương đối của IPCs quan tâm đến các công nghệ chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ.
- Chỉ số mức IPC đề cập đến tỷ lệ số người được cấp bằng sáng chế trung bình trong một bằng sáng chế cho số người được cấp bằng sáng chế trong một công nghệ nhất định. Nếu chỉ số mức độ bằng sáng chế cấp IPC cụ thể là 1, có nghĩa là IPC tương ứng bằng với số lượng trích dẫn trung bình cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ được phân tích.
- Năm đăng ký trung bình của IPC là năm trung bình đăng ký bằng sáng chế do IPC cấp. Đây có thể được sử dụng như là một trong những biện pháp để đánh giá mức độ gần đây nhất của lĩnh vực kỹ thuật chi tiết. Gần đây nhất là năm đăng ký trung bình, các bằng sáng chế đã đăng ký gần đây là rất nhiều.

Bảng 1. Các IPC chính và các số thích trong khu vực công nghệ IPC *

Xếp hạng	IPC	Mô tả IPC	Số bằng sáng chế	Tỷ trọng (%)	Chỉ số cấp	Năm trung bình đăng ký
		Semiconductor devices specially adapted for rectifying, amplifying, oscillating or switching and having at least one potential-jump barrier or surface barrier;Capacitors or resistors with at least one potential-jump barrier or surface barrier; e.g. PN-junction depletion layer or carrier				

5. DEMO (Technology Path)

Introduction

Cây công nghệ cao



Giới thiệu



Điều hướng con đường



Dự án

Mô hình này nhằm cung cấp cho người sử dụng các công nghệ khác nhau mà có thể thu được theo tuần tự từ công nghệ quan tâm (IPC) và một tuyến đường đến nó.

Một đường dẫn công nghệ có nghĩa là một đường dẫn từ một IPC tới một IPC khác trên một bản đồ công nghệ được tạo ra bằng việc cấp IPC đồng thời. Giả sử hai hoặc nhiều IPCs đồng thời cấp bằng sáng chế là các công nghệ cấu thành sáng chế được biết trong bằng sáng chế, và người nộp đơn đang giữ bằng sáng chế có các công nghệ cấu thành sáng chế.

Người sử dụng có thể sử dụng các mô hình khác nhau của COMPAS (phát hiện ra đối thủ cạnh tranh chính, hồ sơ cạnh tranh, vv) để xác định công nghệ quan tâm từ quan điểm của IPC và xác định thành phần của công nghệ (IPC) và cấu trúc thông qua một mô hình công nghệ công nghệ quan tâm. Người dùng có thể điều hướng mô hình này, bắt đầu từ công nghệ quan tâm, để tìm ra một yếu tố công nghệ mới sẵn có và một con đường để đạt được công nghệ mong muốn.

Mô hình này cung cấp các kết quả phân tích sau cùng với các kết quả tìm kiếm đường dẫn kỹ thuật. Các kết quả phân tích có thể tìm thấy trên trang web của COMPAS và có thể được lưu dưới dạng báo cáo riêng.

- Phân tích từng bước
- Phân tích theo tuyến đường

Mô hình này có thể được sử dụng cho người dùng để tìm kiếm các công nghệ mới có thể được kết hợp lại từ thế mạnh của họ, hoặc để tìm kiếm con đường để đạt được công nghệ mà họ muốn bảo đảm trong tương lai.



Sample Report

5. DEMO (Technology Path)

Report

Mục lục +

Điều kiện tìm kiếm

Trong phân tích này, các bằng sáng chế của Mỹ và cơ sở dữ liệu PATSTAT đã được sử dụng, và các đường dẫn công nghệ được phát hiện thông qua lựa chọn từng bước như sau

G03F007→H01L021→C07C257

Tóm tắt lộ trình kỹ thuật

○ Số năm trung bình của năm bằng sáng chế (tích lũy 1, 3, và 5 năm tích lũy), mức tăng trung bình hàng năm của bằng sáng chế (gần đây 3 và 5 năm) 1).

Bảng 1. Tóm tắt các thông tin kỹ thuật đã chọn

Bước	IPC	Mô tả IPC	Số bằng sáng chế			Tốc độ tăng trưởng hàng năm(%)		Năm trung bình đăng ký
			1 năm	3 năm	5 năm	3 năm	5 năm	
1	G03F007	Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printed surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor (using photoresist structures for special production processes, see the relevant places, e.g. B44C, H01L, e.g. H01L 21/00, H05K) [3,5]	1872	5129	6549	16.98	26.37	2014.53
2	H01L021	Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof (processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of devices provided for in groups H01L 31/00-H01L 51/00 or of parts thereof, see these groups; single-step processes covered by other subclasses, see the relevant subclasses, e.g. C23C, C30B; photomechanical production of textured or patterned surfaces, materials or originals therefor, apparatus specially adapted therefor, in general G03F) [2,8] H01L 21/02 - H01L 21/67 Note(s) Group H01L 21/70 takes precedence over groups H01L 21/02-H01L 21/67. [2]	12408	33675	47842	14.02	16.72	2014.33
		Compounds containing carboxyl groups, the doubly-bound oxygen atom of a carboxyl group being replaced by a doubly-bound						

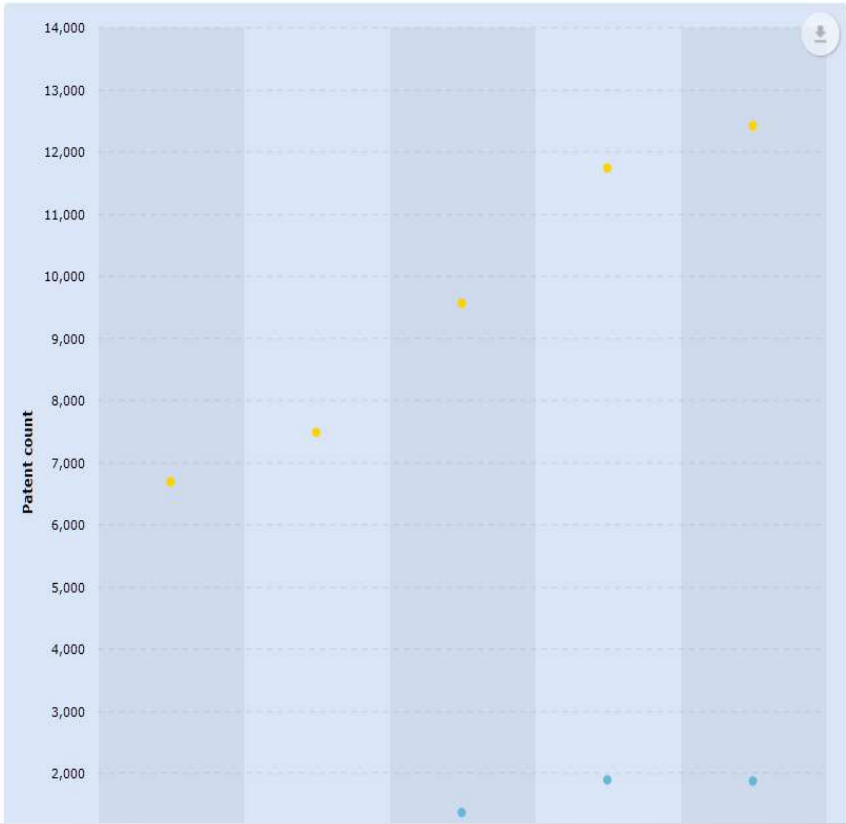
1. Phân tích từng bước

1-1. Số bằng sáng chế theo năm

○ Tốc độ phát triển mới nhất của từng công nghệ bước được xác định thông qua số đăng ký IPC hàng năm, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm và thông tin đăng ký trung bình năm (Bảng 3, hình 1)

Bảng 3. Số bằng sáng chế theo năm

Bước	IPC	2013	2014	2015	2016	2017	Tổng cộng	Tốc độ tăng trưởng hàng năm(%)	Năm trung bình đăng ký
1	G03F007	734	686	1368	1889	1872	6549	26.37	2014.53
2	H01L021	6686	7481	9544	11723	12408	47842	16.72	2014.33
3	C07C257	11	10	13	14	13	61	4.26	2014.13



5. DEMO (Core Patents)

Introduction

Bảng sáng chế chính

 Giới thiệu	 Chỉ định nhóm công nghệ	 Dự án
--	---	---

Mô hình này nhằm mục đích khám phá các bằng sáng chế quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ trong một lĩnh vực công nghệ cụ thể.

Lĩnh vực công nghệ mà mô hình được áp dụng đề cập đến một bộ các bằng sáng chế được chỉ định bởi người dùng. Sử dụng chức năng tìm kiếm bằng sáng chế COMPAS, người dùng có thể tìm kiếm lĩnh vực công nghệ mà họ quan tâm, và kết quả tìm kiếm được lưu trữ trong COMPAS. Trong quá trình thực hiện mô hình, người dùng chỉ định kết quả tìm kiếm như là một bộ bằng sáng chế sẽ được sử dụng để phân tích.

Đối với lĩnh vực công nghệ được chỉ định, mô hình này chọn các bằng sáng chế có tầm quan trọng cao thông qua chỉ số định lượng dựa trên trích dẫn. Để làm được điều này, chúng tôi cân nhắc việc trích dẫn các bằng sáng chế có ảnh hưởng trong mạng lưới trích dẫn và điều chỉnh hiện tượng mà các trích dẫn tập trung vào các bằng sáng chế cũ, và tính giá trị Tác động của mỗi bằng sáng chế.

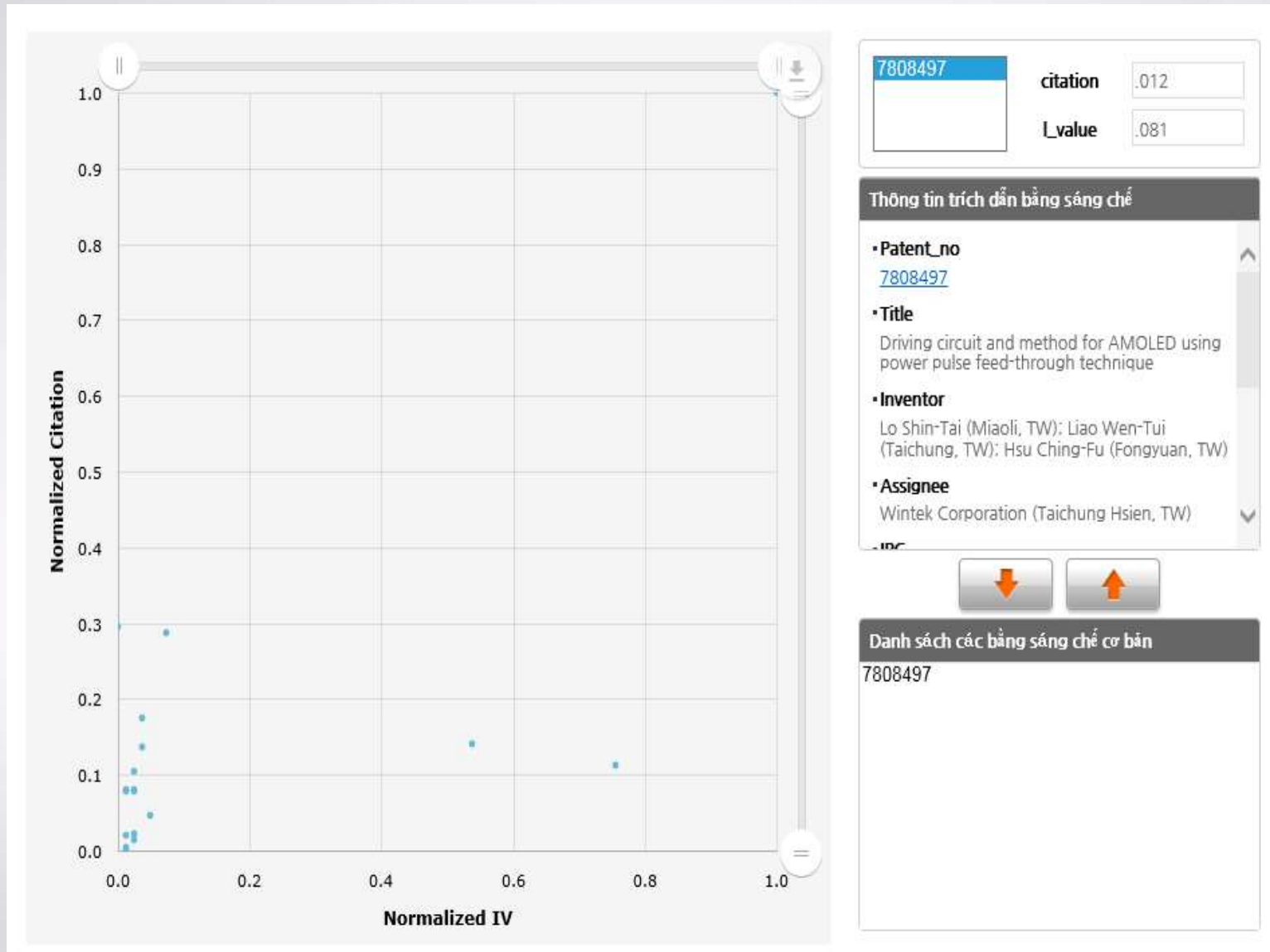
Người sử dụng có thể chọn các bằng sáng chế có tầm quan trọng cao trong bất kỳ lĩnh vực công nghệ và sử dụng chúng để nắm bắt tình trạng và công nghệ cốt lõi của lĩnh vực có liên quan.

 Sample Report

>

5. DEMO (Core Patents)

Core Patent



5. DEMO (Core Patents)

Report

Mục lục

+

1. Điều kiện tìm kiếm

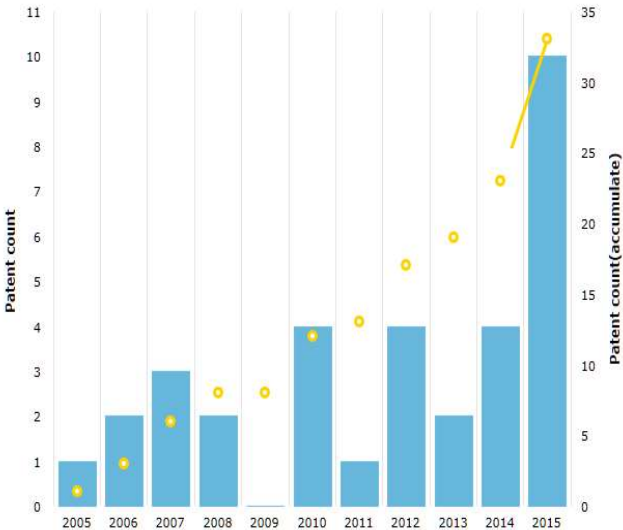
Trong phân tích này, dữ liệu bằng sáng chế của Mỹ đã được sử dụng, và công thức tìm kiếm để tìm kiếm bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ liên quan như sau

(tft:(amoled) AND abst:(amoled)) AND pd:[2001-01-01 TO 2015-12-01]

Tổng số sáng chế được tìm kiếm là 33, và xu hướng hàng năm như sau

Bảng 1-1. Số bằng sáng chế theo năm

Năm	Số bằng sáng chế	Số bằng sáng chế cộng dồn
2005	1	1
2006	2	3
2007	3	6
2008	2	8
2009	0	8
2010	4	12
2011	1	13
2012	4	17
2013	2	19
2014	4	23
2015	10	33

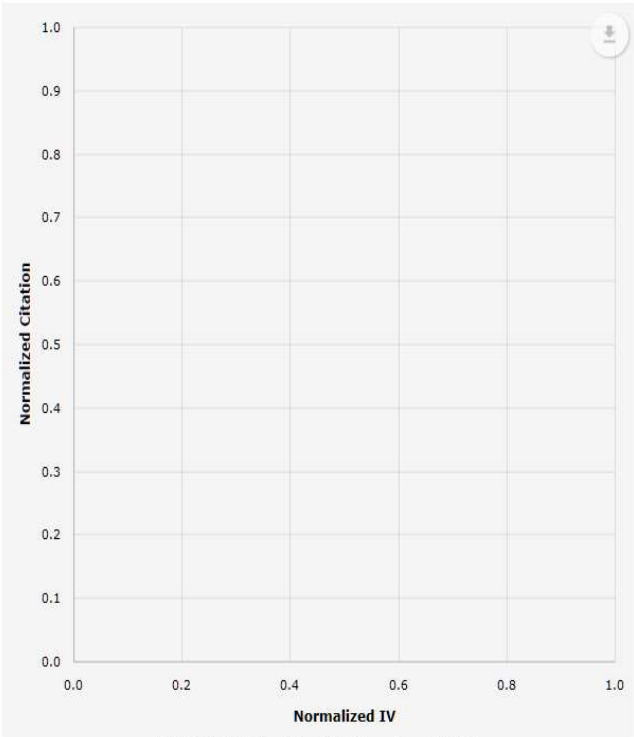


2. Danh sách sáng chế chính

Thông tin thư mục của các bằng sáng chế cơ bản do người sử dụng lựa chọn được thể hiện trong Bảng 2-1.

Bảng 2-1. Thông tin Thư mục Chia khoá Bằng sáng chế

No	Số bằng sáng chế	Năm đăng ký	Tiêu đề bằng sáng chế chính	Người nộp đơn	Số lượng trích dẫn	i-value
1	7808497	2010	Driving circuit and method for AMOLED using power pulse feed-through technique	Wintek Corporation (Taichung Hsien, TW)	1	3.51



Hình 2-1. Các kết quả tìm kiếm bằng sáng chế chính

3. Danh sách các bằng sáng chế có liên quan

Cung cấp một danh sách các bằng sáng chế đóng góp vào tầm quan trọng của các bằng sáng chế cơ bản được lựa chọn

5. DEMO (Journal Article Analysis)

Introduction

Phân tích bài báo khoa học



Giới thiệu



Tải lên dữ liệu



Dự án

Trong khi mô hình Nhận dạng đối thủ cạnh tranh phân tích các công nghệ quan tâm (TOI) theo góc nhìn công nghệ, thường được thể hiện qua các sáng chế, người dùng cũng có thể muốn biết những gì đang diễn ra theo góc nhìn khoa học

Mô hình Phân tích bài báo khoa học cung cấp phương tiện phân tích tham chiếu trích dẫn khoa học của các bài báo do người dùng xác định.

Để sử dụng mô hình này, người dùng phải trực tiếp tìm kiếm trang web Thomson Web Knowledge, trang Scopus, trang Pubmed, và tải về thông tin thư mục của luận án có liên quan. Định dạng của tệp được tải xuống là văn bản thuần túy. (làm thế nào để tải về các tập tin văn bản được mô tả chi tiết trong Hướng dẫn sử dụng)

Trong quá trình lập mô hình, người dùng tải lên tệp tin đã tải xuống hệ thống COMPAS.

Việc phân tích các xu hướng trong lĩnh vực kỹ thuật được chỉ định bởi người sử dụng được thực hiện thông qua các mục sau đây. Kết quả có thể được xem trên trang web của COMPAS cũng như dưới dạng các báo cáo riêng biệt.

- Tổng số bài báo / năm
- Số bài báo theo quốc gia, tổ chức (theo năm xuất bản)
- Chất lượng bài báo (Q-factor) theo tác giả, quốc gia, tổ chức
- Chỉ số hoạt động theo quốc gia, tổ chức
- Chỉ số hợp tác Quốc tế theo quốc gia, tổ chức
- Danh sách các tổ chức và tác giả chính
- Các bài báo được trích dẫn cao
- Các tổ chức nghiên cứu Hàn Quốc

5. DEMO (Journal Article Analysis)

Report

Mục lục +

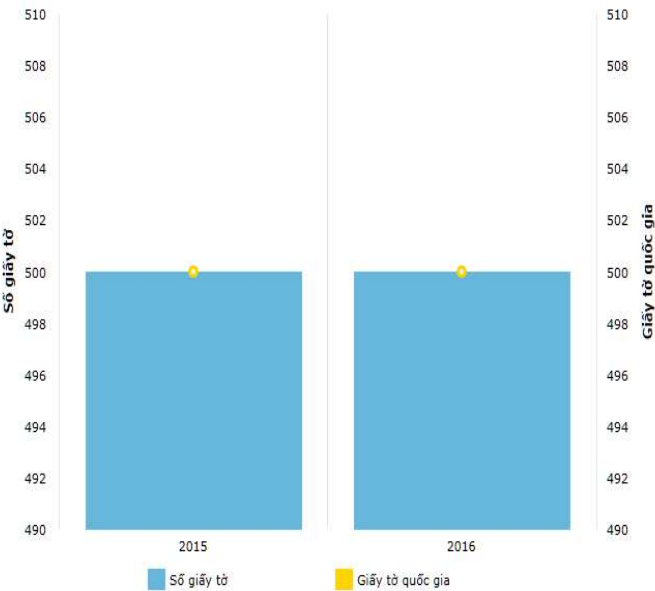
Điều kiện tìm kiếm

Trong phân tích này, cơ sở dữ liệu WebofScience đã được sử dụng.
nano
Năm truy xuất được giới hạn trong giai đoạn 2015-2016, và tổng số bài báo thu được là 1000.

1. Số lượng giấy tờ theo năm

Bảng 1-1. Số lượng giấy tờ theo năm
(Các giấy tờ quốc gia đề cập đến giấy tờ có quốc tịch là người Hàn Quốc.)

Năm	Số giấy tờ	Số lượng giấy tờ tích lũy	Giấy tờ quốc gia
2015	500	500	500
2016	500	1,000	500



Hình ảnh 1-1. Xu hướng của các bài báo theo năm
(Tổng số giấy tờ là một biểu đồ thanh, và số lượng giấy tờ ở Hàn Quốc là một biểu đồ đường)

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của giai đoạn phân tích là 0% dựa trên số lượng bài báo và 100% dựa trên tổng số bài báo.

2. Phân tích quốc gia

2-1. Số giấy tờ theo quốc gia

Biểu 1-2. Phân bố luận văn theo quốc gia

Xếp hạng	Quốc gia	Số giấy tờ	Tỷ trọng (%)
1	South Korea	1,000	100.000
2	USA	145	14.500
3	China	42	4.200
4	Germany	33	3.300
5	India	26	2.600
5	Japan	26	2.600
7	Spain	23	2.300
8	UK	22	2.200
9	France	20	2.000
10	Italy	17	1.700
10	Czech Republic	17	1.700

*Nó dựa trên một bài báo không thể trích dẫn thông tin về đất nước.

- Phân tích tác giả của wos-nano cho thấy 70 quốc gia trên thế giới đã thực hiện nghiên cứu liên quan.
- Trong số các nước này, South Korea đã xuất bản 1,000 bài báo, chiếm 100.000% trong tổng số 1000 giấy tờ, và các giấy tờ được xuất bản nhiều nhất.
- USA là 145miếng (14.500%), China là 42miếng (4.200%) tờ báo đã được công bố và đứng thứ 2 và thứ 3.
- Đất nước này đứng thứ 1 bằng cách xuất bản 1000 bài báo (100.000%).

2-2. Số bài viết mỗi năm ở mỗi quốc gia

Table 1-3. Số giấy tờ theo quốc gia theo năm

Year	2015	2016	Toàn diện
South Korea	500	500	1,000
USA	76	69	145
China	23	19	42
Germany	19	14	33
India	17	9	26
Japan	12	14	26
Spain	8	15	23
UK	17	5	22
France	13	7	20
Italy	14	3	17
Czech Republic	7	10	17

*Nó dựa trên một bài báo không thể trích dẫn thông tin về đất nước.

Thank you!

